

第59回 応用物理学関係連合講演会 シンポジウム

ポストスケーリング時代における 次世代革新的デバイスおよび材料の探索

JST戦略的創造研究事業さきがけ

「革新的次世代デバイスを目指す材料とプロセス」の成果を
応用物理学会シンポジウムの中で発表いたします。

日時：2012年3月15日（木） 9:00～17:45

会場：早稲田大学 早稲田キャンパス 15号館 201 (F6)
東京都新宿区西早稲田 1-6-1

プログラム

- 9:00 - 9:05 佐藤勝昭 (JST) 基礎研究が拓くポストスケーリング時代
- 9:05 - 9:35 竹中 充 (東大) 光配線 LSI 実現に向けた Ge ナノ光電子集積回路の開発
- 9:35-10:05 中岡俊裕 (上智大) 量子ドットを用いた単電荷・スピン・光機能融合デバイス
- 10:05-10:35 水落憲和 (阪大) ワイドギャップ半導体中の単一常磁性発光中心による量子情報素子
- 10:35-11:05 川山 巖 (阪大) ナノ構造制御した光生成磁束量子デバイスの創製
- 11:05-11:45 横山直樹 (産総研) 最先端研究開発支援プロジェクト「グリーンナノエレクトロニクスのコア技術開発」
-
- 13:00-13:40 名西愷之 (立命館大) 窒化物半導体新領域開拓に向けての材料技術最近の展開
- 13:40-14:10 片山竜二 (東北大) 極性ワイドギャップ半導体フォトニックナノ構造の新規光機能
- 14:10-14:40 寒川義裕 (九大) オンチップ光配線用窒化物基板の創製とシステム熱設計支援
- 14:40-15:10 須崎友文 (東工大) ワイドギャップ酸化物における界面機能開発
-
- 15:25-16:05 湯浅新治 (産総研) Magnetoresistance and spin-transfer torque in magnetic tunnel junctions
- 16:05-16:35 浜屋宏平 (九大) Si 系半導体ナノ構造を基礎とした単一電子スピントランジスタの開発
- 16:35-17:05 福村知昭 (東大) ワイドギャップ強磁性半導体デバイス
- 17:05-17:35 小林 航 (筑波大) サーモエレクトロニクスを指向した基礎材料の開発
- 17:35-17:45 小田俊理 (東工大) クロージングトーク

